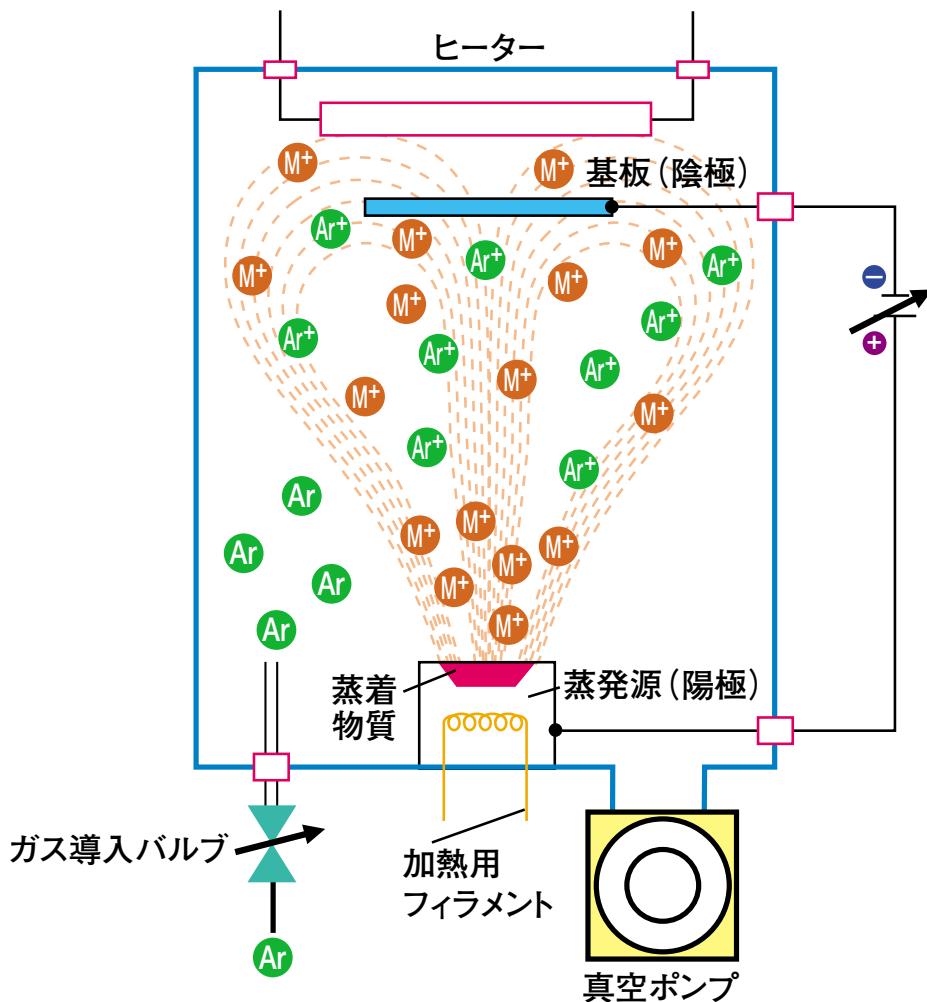


④ イオンプレーティング



基板に数kVの負電圧を印加し、数Paのアルゴン (Ar) ガス圧力で真空蒸着を行います。このとき導入されたArガスや蒸発粒子のイオンは、基板近傍の陰極暗部の電位差で加速されて基板に衝突します。そのため、付着力の強い膜が得られます。さらに、平均自由行程の短い圧力下での成膜であるため、蒸発粒子が衝突散乱し、立体物基板への付き回りが良くなります。

また、アセチレン (C_2H_2)、酸素 (O_2)、窒素 (N_2) などの反応性ガスを導入すれば、炭化物、酸化物、窒化物などの成膜もできます。